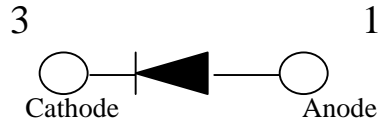




Schottky Diode (FHBAT54)

肖特基二极管



MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	V_R	30	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I_F	200	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	P_D	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	P_D	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T_J, T_{stg}	150 , -55 to +150	

DEVICE MARKING 打标

FHBAT54=1S

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25)

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流($V_R=25$ Vdc)	I_R	—	1.0	μ Adc
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压($I_{BR}=10 \mu$ Adc)	$V_{(BR)}$	30	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ($I_F=0.1$ mAdc)	V_F	—	240	mVdc
($I_F=1$ mAdc)		—	320	
($I_F=10$ mAdc)		—	400	
($I_F=30$ mAdc)		—	500	
($I_F=100$ mAdc)		—	1000	
Total Capacitance 电容($V_R=1$ V, $f=1.0$ MHz)	C_T	—	10	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间($I_F=I_R=10$ mAdc, $R_L=100$)	t_{rr}	—	5.0	ns



SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

